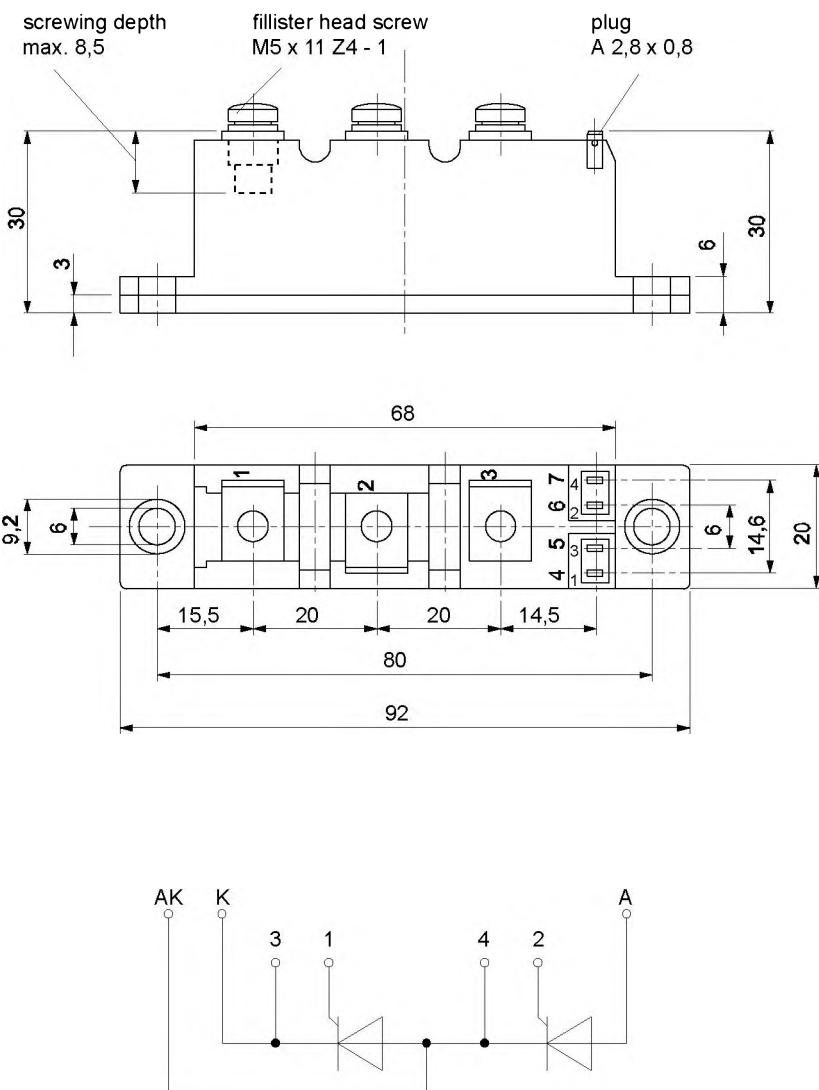


European Power-
Semiconductor and
Electronic Company

Marketing Information TT 93 N



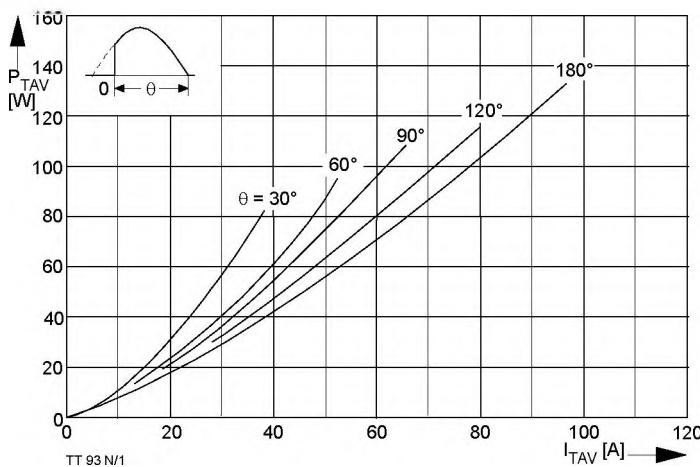


Bild / Fig. 1

Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
 $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

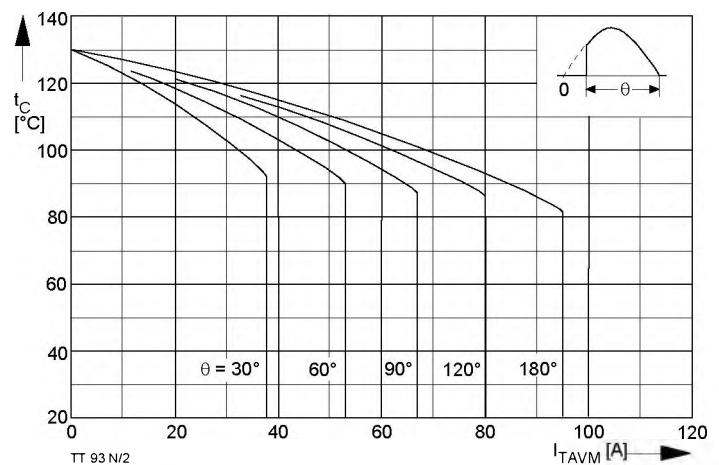


Bild / Fig. 2

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

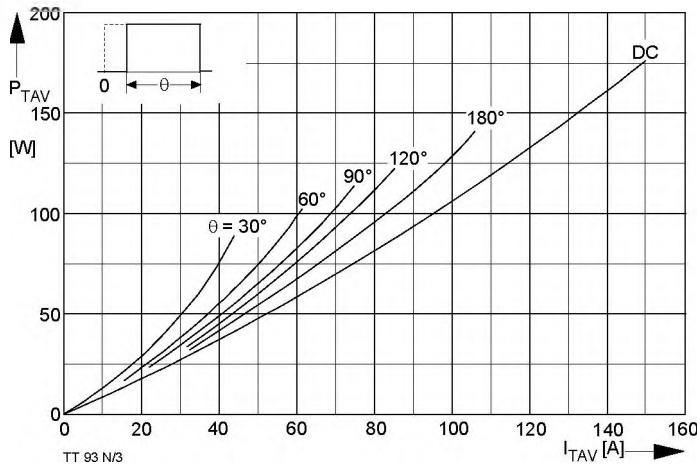


Bild / Fig. 3

Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
 $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

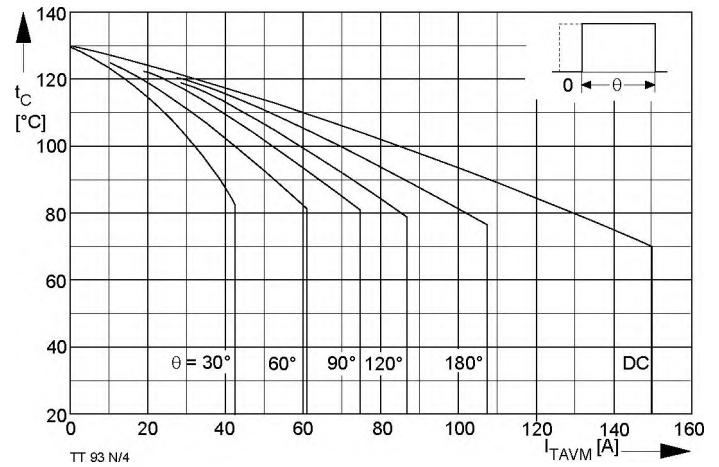


Bild / Fig. 4

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

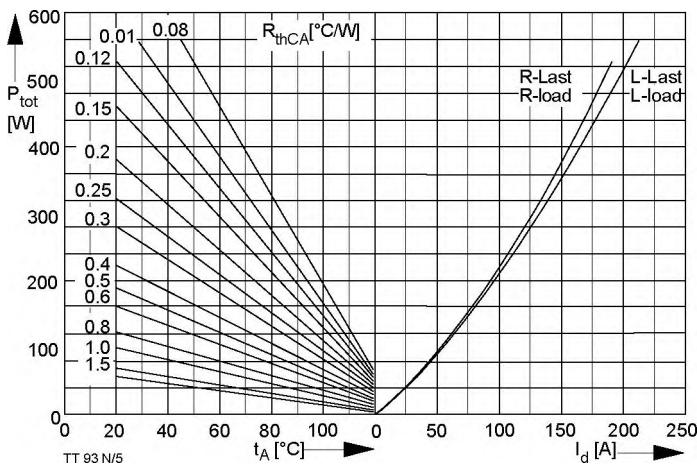


Bild / Fig. 5

B2 - Zweipuls-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit
Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d
Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient R_{thCA}

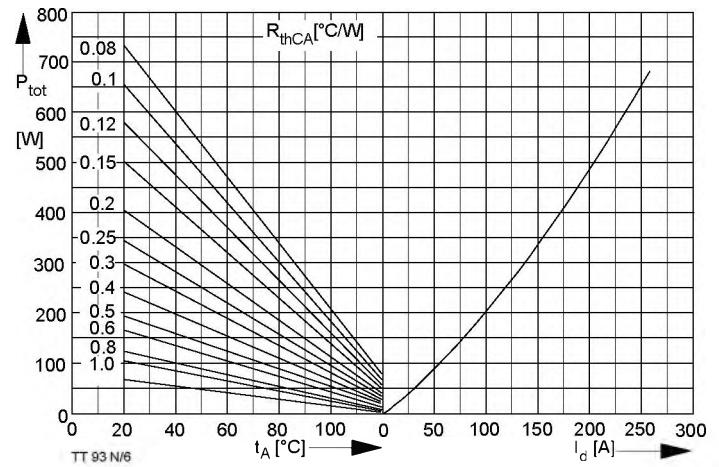


Bild / Fig. 6

B6 - Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit
Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d
Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient R_{thCA}

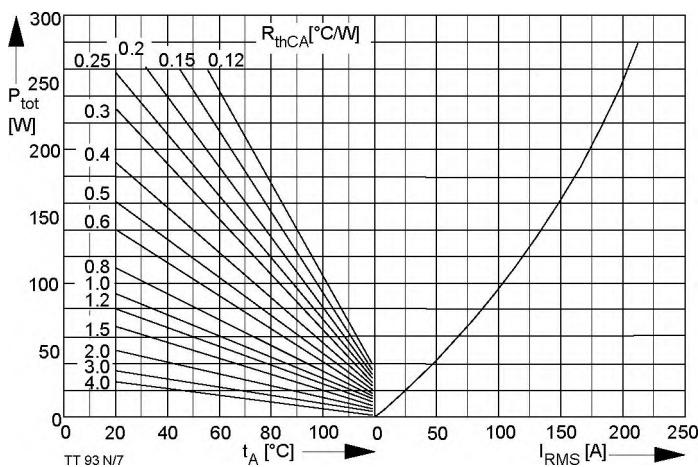


Bild / Fig. 7

W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

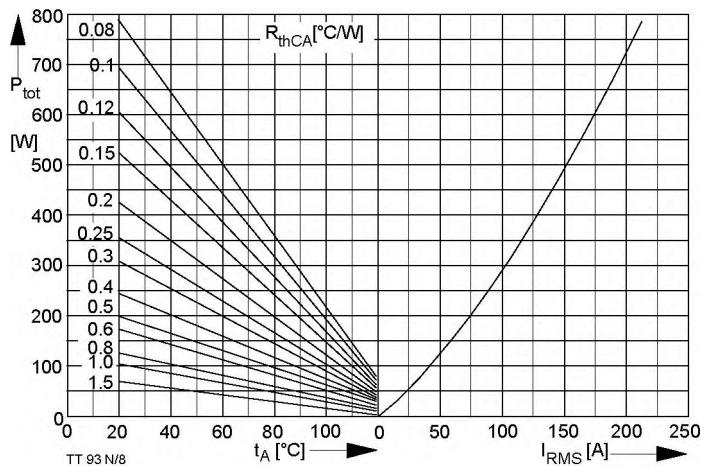


Bild / Fig. 8

W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom je Phase / Maximum rated RMS current per phase I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

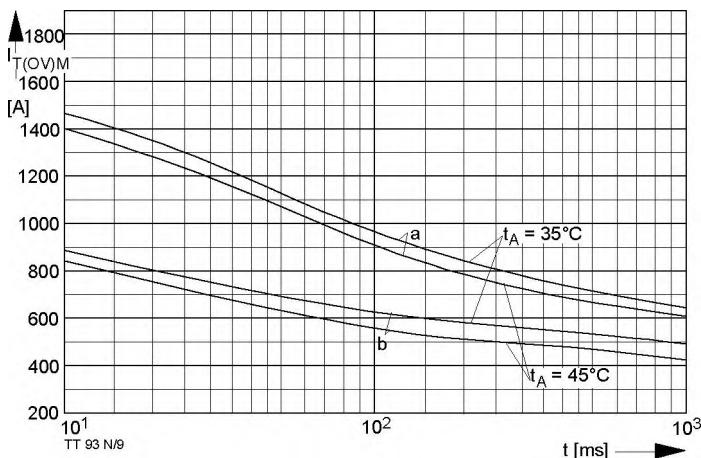


Bild / Fig. 9

Grenzstrom je Zweig $I_{\text{T(OV)M}}$ bei Luftselbstkühlung, $t_A=45^\circ\text{C}$ und verstärkter Luftkühlung, $t_A=35^\circ\text{C}$, Kühlkörper KP 0,33S, $V_{\text{RM}} = 0.8 V_{\text{RRM}}$.
Limiting overload on state current per arm $I_{\text{T(OV)M}}$ at natural ($t_A=45^\circ\text{C}$) and forced ($t_A=35^\circ\text{C}$) cooling, heatsink type KP 0,33S, $V_{\text{RM}}=0.8 V_{\text{RRM}}$.
a - Belastung nach Leerlauf / current surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom I_{TAVM} /
Current surge occurs during operation at limiting mean on-state current rating I_{TAVM}

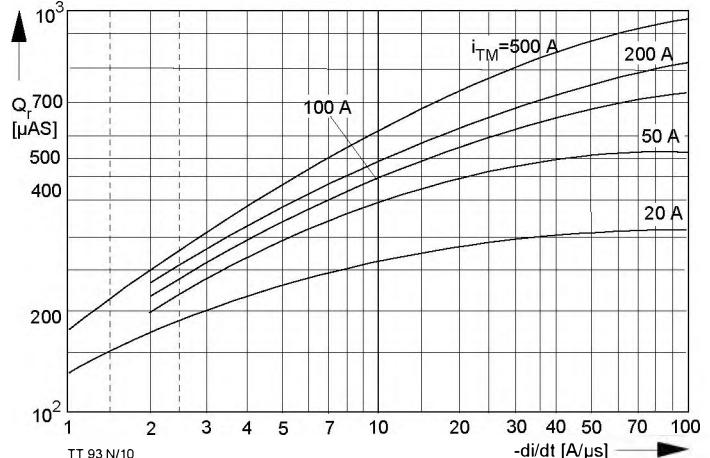


Bild / Fig. 10

Spererverzögerungsladung / Recovery charge $Q_r = f(-di/dt)$
 $t_{vj} = t_{vj\max}$, $V_R \leq 0.5 V_{\text{RRM}}$, $V_{\text{RM}} = 0.8 V_{\text{RRM}}$
Parameter Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}

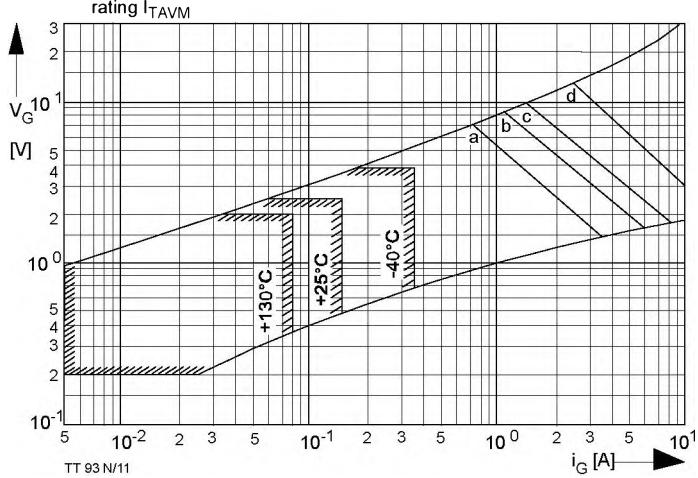


Bild / Fig. 11

Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas, $v_G = f(i_G)$, $v_D = 6 \text{ V}$
Parameter:
Steuerimpulsdauer / Pulse duration t_q [ms] a b c d
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power [W] 5 10 15 30

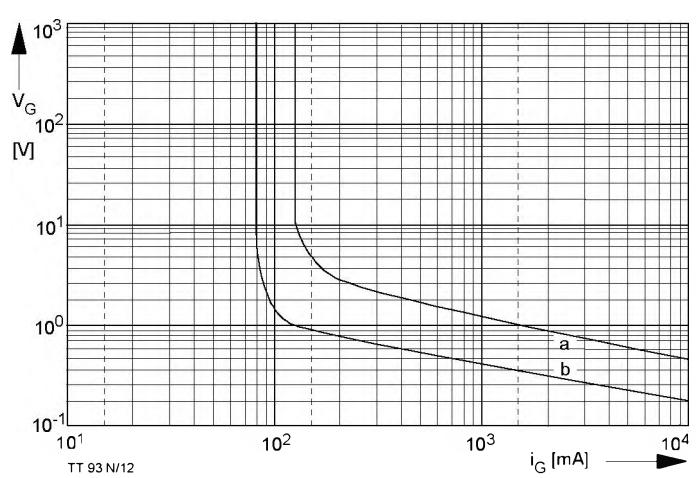


Bild / Fig. 12

Zündverzug / Gate controlled delay time $t_{\text{gd}} = f(i_G)$
 $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $di_G/dt = i_{\text{GM}}/1\mu\text{s}$
a - äußerster Verlauf / limiting characteristic
b - typischer Verlauf / typical characteristic

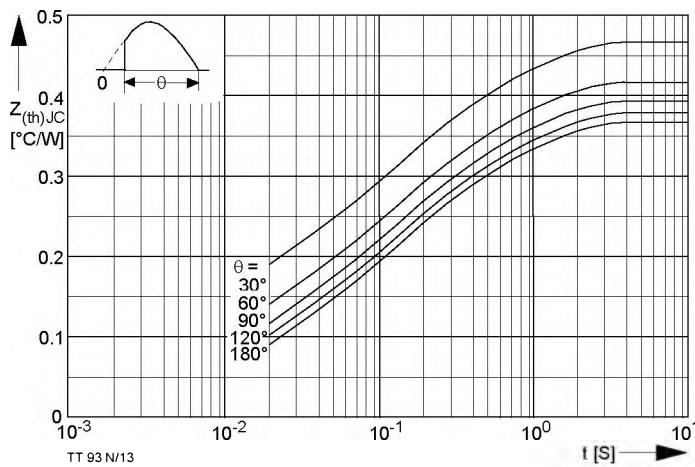


Bild / Fig. 13

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [\text{°C/W}]$	0,0059	0,0205	0,0786	0,174	0,06		
$\tau_n [\text{s}]$	0,000045	0,0022	0,0285	0,222	1,19		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$

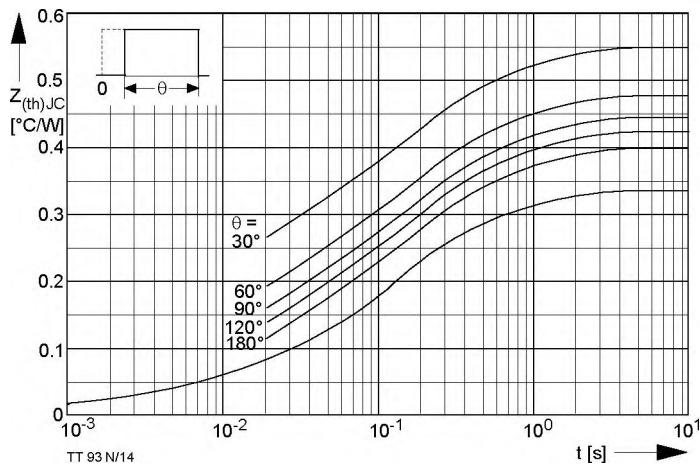


Bild / Fig. 14

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

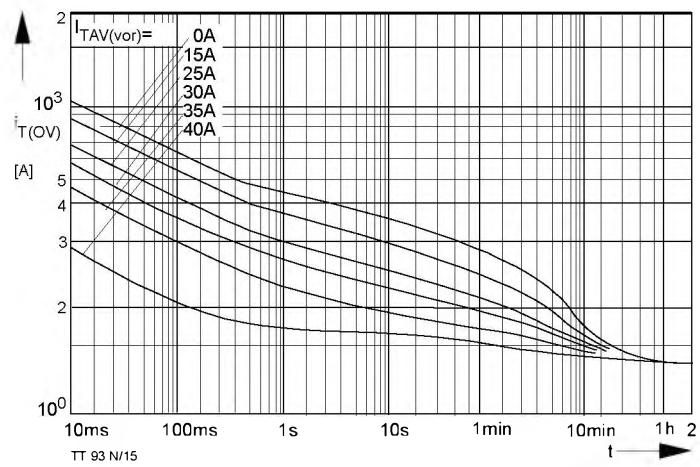


Bild / Fig. 15

B2 - Zweipuls - Brückenschaltung / Two - pulse bridge circuit
Überstrom je Zweig $I_{T(OV)}$ bei Luftselbstkühlung, $t_A=45^\circ\text{C}$,
Kühlkörper KP0,33S /
Overload on-state current per arm $I_{T(OV)}$ at natural cooling, $t_A=45^\circ\text{C}$,
heatsink type KP 0,33S
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm $I_{TAV(vor)}$

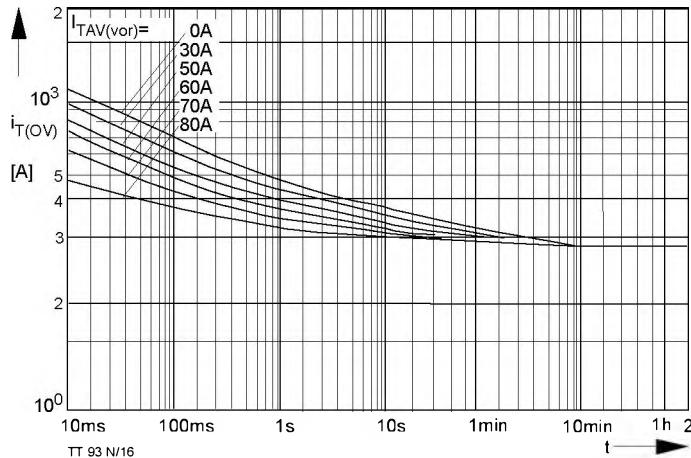


Bild / Fig. 16

B2 - Zweipuls - Brückenschaltung / Two - pulse bridge circuit
Überstrom je Zweig $I_{T(OV)}$ bei verstärkter Luftkühlung, $t_A=35^\circ\text{C}$, $V_L=90\text{l/s}$,
Kühlkörper KP0,33S /
Overload on-state current per arm $I_{T(OV)}$ at forced cooling, $t_A=35^\circ\text{C}$, $V_L=90\text{l/s}$,
heatsink type KP 0,33S.
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm $I_{TAV(vor)}$

TT 93 N

Elektrische Eigenschaften		Electrical properties				
Höchstzulässige Werte		Maximum rated values				
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung		repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots +130^\circ\text{C}$	V_{DRM}	600	800 1000
Vorwärts-Stoßspitzen-Sperrspannung		non-repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots +130^\circ\text{C}$	V_{RRM}	1200	1400 1600
Rückwärts-Stoßspitzen-Sperrspannung		non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots +130^\circ\text{C}$	V_{DSM}	600	800 1000
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert		RMS on-state current		V_{RSM}	1200	1400 1600
Dauergrenzstrom		average on-state current	$t_c = 85^\circ\text{C}$	I_{TRMSM}	700	800 1100
Stoßstrom-Grenzwert		surge current	$t_c = 83^\circ\text{C}$	I_{TAVM}	1300	1500 1700
Grenzlastintegral		$I^2 t$ -value	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	I_{TSM}	150	A
Kritische Stromteilheit		critical rate of rise of on-state current	$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2 t$	93	A
Kritische Spannungsteilheit		critical rate of rise of off-state voltage	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2 t$	96	A
			$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I_{GM} = 0,6 \text{ A}, di_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}$	23,1 . 10 ³	$\text{A}^2 \text{s}$
				$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 0,67 V_{DRM}$	17,1 . 10 ³	$\text{A}^2 \text{s}$
				6.Kennbuchstabe/6th letter F	120	$\text{A}/\mu\text{s}$
					1000	$\text{V}/\mu\text{s}$
Charakteristische Werte		Characteristic values				
Durchlaßspannung		on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, i_T = 300 \text{ A}$	V_T	max. 1,64	V
Schleusenspannung		threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}$	$V_{T(TO)}$	0,85	V
Ersatzwiderstand		slope resistance	$t_{vj} = t_{vj \max}$	r_T	2,2	$\text{m}\Omega$
Zündstrom		gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	I_{GT}	max. 150	mA
Zündspannung		gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	V_{GT}	max.2,5	V
Nicht zündender Steuerstrom		gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 6 \text{ V}$	I_{GD}	max. 5	mA
Nicht zündende Steuerspannung		gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD}	max. 2,5	mA
Haltestrom		holding current	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	I_H	max. 0,2	V
Einraststrom		latching current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_A = 5 \Omega$	I_L	max. 200	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom		forward off-state and reverse currents	$t_{vj} = t_{vj \max}$	i_D, i_R	max. 600	mA
Zündverzug		gate controlled delay time	$V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$ DIN IEC 747-6, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $i_{GM} = 0,6 \text{ A}, di_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}$	t_{gd}	max.1,2	μs
Freiwerdezeit		circuit commutated turn-off time	$t_{vj} = t_{vj \max}, i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100 \text{ V}, V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20 \text{ V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$ 5.Kennbuchstabe/5th letter O	t_q	typ.120	μs
Isolations-Prüfspannung		insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, 1 min	V_{ISOL}	2,5	kV
Thermische Eigenschaften		Thermal properties				
Innerer Wärmewiderstand		thermal resistance, junction to case	pro Modul/per module, $\Theta = 100^\circ\text{C}/\text{W}$ pro Zweig/per arm, $\Theta = 180^\circ\text{sin}(\alpha)/\text{W}$ pro Modul/per module, DC pro Zweig/per arm, DC	R_{thJC}	max. 0,18	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand		thermal resistance, case to heatsink	pro Modul/per module pro Zweig/per arm	R_{thCK}	max. 0,36	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzul. Sperrschiichttemperatur		max. junction temperature	$t_{vj \max}$		max. 0,17	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Betriebstemperatur		operating temperature	$t_{c op}$		max. 0,34	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Lagertemperatur		storage temperature	t_{stg}		max. 0,05	$^\circ\text{C}/\text{W}$
					max. 0,10	$^\circ\text{C}/\text{W}$
					130	$^\circ\text{C}$
					-40...+130	$^\circ\text{C}$
					-40...+130	$^\circ\text{C}$
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties				
Gehäuse, siehe Seite		case, see page				1
Si-Elemente mit Lötkontakt, glaspassiviert		Si-pellet with soldered contact, glass-passivated				
Innere Isolation		internal insulation				Al_2O_3
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung		mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	M1	4	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse		terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%	M2	4	Nm
Gewicht		weight		G	typ.125	g
Kriechstrecke		creepage distance			12,5	mm
Schwingfestigkeit		vibration resistance	f = 50 Hz		50	m/s^2
Kühlkörper / heatsinks: KP 0,5 S; KP 0,41 S; KP 0,35 S; KP 0,33 S						